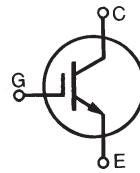


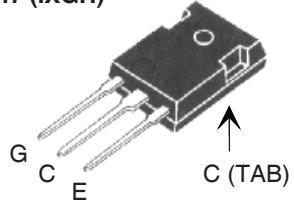
High Voltage IGBT

IXGH24N170 IXGT24N170

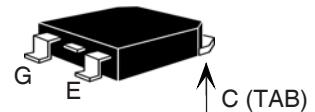


V_{CES} = 1700V
I_{C25} = 50A
V_{CE(sat)} ≤ 3.3V
t_{fi(typ)} = 250ns

TO-247 (IXGH)



TO-268 (IXGT)



G = Gate C = Collector
 E = Emitter TAB = Collector

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	T _c = 25°C to 150°C	1700	V
V_{CGR}	T _j = 25°C to 150°C, R _{GE} = 1MΩ	1700	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	T _c = 25°C	50	A
I_{C90}	T _c = 90°C	24	A
I_{CM}	T _c = 25°C, 1ms	150	A
SSOA (RBSOA)	V _{GE} = 15V, T _{vJ} = 125°C, R _G = 5Ω	I _{CM} = 50	A
	Clamped inductive load	@ 0.8 • V _{CES}	
t_{sc}	V _{GE} = 15V, T _{vJ} = 125°C, V _{CE} = 1000V	10	μs
(SCSOA)	R _G = 5Ω, non repetitive		
P_c	T _c = 25°C	250	W
T_j		-55 ... +150	°C
T_{JM}		150	°C
T_{stg}		-55 ... +150	°C
T_L	1.6mm (0.062 in.) from case for 10s	300	°C
T_{SOLD}	Plastic body for 10 seconds	260	°C
M_d	Mounting torque (TO-247)	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

Symbol	Test Conditions (T _j = 25°C unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	I _c = 250μA, V _{GE} = 0V	1700		V
V_{GE(th)}	I _c = 250μA, V _{CE} = V _{GE}	3.0		V
I_{CES}	V _{CE} = 0.8 • V _{CES} V _{GE} = 0V		50 μA 500 μA	
I_{GES}	V _{CE} = 0V, V _{GE} = ± 20V		±100 nA	
V_{CE(sat)}	I _c = I _{C90} , V _{GE} = 15V, Note 1 T _j = 125°C	2.5 3.0	3.3	V

Features

- International standard packages JEDEC TO-268 and JEDEC TO-247 AD
- High current handling capability
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Rugged NPT structure
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Applications

- Capacitor discharge & pulser circuits
- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switched-mode and resonant-mode power supplies

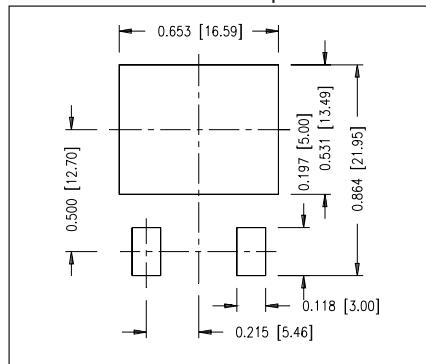
Advantages

- High power density
- Suitable for surface mounting
- Easy to mount with 1 screw, (isolated mounting screw hole)

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$, $V_{CE} = 10\text{V}$, Note 1	18	25	S
$I_{C(ON)}$	$V_{CE} = 10\text{V}$, $V_{GE} = 10\text{V}$	100		A
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}$, $V_{GE} = 0\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$	2400		pF
C_{oes}		120		pF
C_{res}		33		pF
Q_g	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{V}$, $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$	106		nC
Q_{ge}		18		nC
Q_{gc}		32		nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C25}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 5\Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) > $0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G	42		ns
t_{ri}		39		ns
$t_{d(off)}$		200	400	ns
t_{fi}		250	500	ns
E_{off}		8	12	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C25}$, $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$, $R_G = R_{off} = 5\Omega$ Remarks: Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) > $0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G	50		ns
t_{ri}		55		ns
E_{on}		2.0		mJ
$t_{d(off)}$		200		ns
t_{fi}		360		ns
E_{off}		12		mJ
R_{thJC}			0.50	°C/W
R_{thCS}	(TO-247)	0.25		°C/W

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

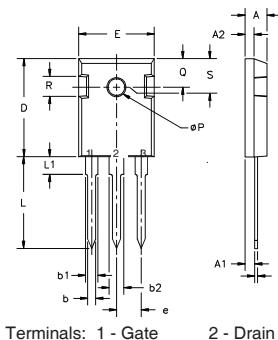
Min Recommended Footprint



ADVANCE TECHNICAL INFORMATION

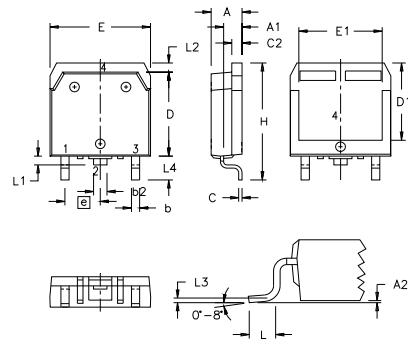
The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from a subjective evaluation of the design, based upon prior knowledge and experience, and constitute a "considered reflection" of the anticipated result. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter Min.	Millimeter Max.	Inches Min.	Inches Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L ₁		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216

TO-268 Outline



Terminals: 1 - Gate 2 - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC	.545 BSC		
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC	.025 BSC		
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 7,005,734 B2 7,157,338B2 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405 B2 6,759,692 7,063,975 B2 4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2 7,071,537



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331